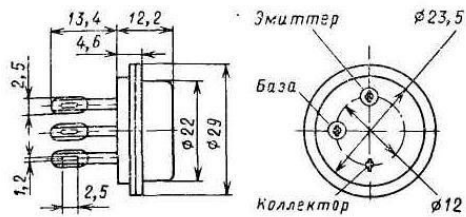


1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В, ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные р-р-р переключаемые низкочастотные мощные
 Предназначены для работы в импульсных схемах, преобразователях тока и стабилизаторах тока и напряжения

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.
 Масса транзистора не более 28 г



Электрические параметры

Граничное напряжение при $I_C = 3$ А, $\tau_{и} \leq 50$ мкс, $f = 20 \div 50$ Гц не менее

1Т806А	40 В
1Т806Б	65 В
1Т806В	80 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер не более:
 при $I_K = 20$ А, $I_B = 2$ А 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В 0,6 В
 при $I_K = 15$ А, $I_B = 2$ А ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д 0,6 В

Напряжение насыщения база-эмиттер не более:
 при $I_K = 20$ А, $I_B = 2$ А 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В 0,8 В
 при $I_K = 15$ А, $I_B = 2$ А ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д 1,0 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (на границе насыщения)
 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В.
 при $T_K = 298$ К, $I_K = 10$ А 10-100
 при $T_K = 343$ К, $I_K = 5$ А 10-100
 при $T = 213$ К, $I_K = 10$ А 10-150

ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д:
 при $T_K = 298$ К, $I_K = 10$ А 10-100
 при $T_K = 328$ К, $T_K = 5$ А 10-200
 при $T = 218$ К, $I_K = 10$ А 8-100

Время выключения при $U_{КЭ} = 45$ В, $I_K = 5$ А, $I_B = 0,25$ А не более 30 мкс

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 5$ В, $I_K = 1$ А не менее 10 МГц

Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{БЭ} = 1$ В, $U_{КЭ} = 75$ В 1Т806А; при $U_{КЭ} = 100$ В 1Т806Б, при $U_{КЭ} = 120$ В 1Т806В не более
 при $T = 298$ К и $T = 213$ К 12 мА
 при $T = 343$ К 25 мА
 при $T = 298$ К $U_{КЭ} = U_{КЭ \text{ макс}}$ ГТ806А, ГТ806Б,

ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д	15 мА
Обратный ток эмиттера не более	
при $U_{БЭ} = 2$ В 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В	5 мА
при $U_{БЭ} = 1,5$ В ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д	8 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $U_{БЭ} = 1$ В

1Т806А, ГТ806А	75 В
1Т806Б, ГТ806Б	100 В
1Т806В, ГТ806В	120 В
ГТ806Г	50 В
ГТ806Д	140 В

Постоянное напряжение база-эмиттер

1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В	2 В
ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д	1,5 В

Постоянный ток коллектора в режиме насыщения

1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В	20 А
ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д	15 А

Импульсный ток коллектора в режиме насыщения при $Q \geq 2$, $\tau_{и} = 1000$ мкс, $K_{нас} = 1$ 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В 25 А

Постоянный ток базы 3 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом при $T_K < 298$ К 30 Вт
 без теплоотвода при $T < 298$ К 2 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус 2 К/Вт
 Тепловое сопротивление переход-среда 30 К/Вт
 Температура перехода 358 К

Температура окружающей среды
 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В до $T_K = 343$ К
 ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д до $T_K = 328$ К

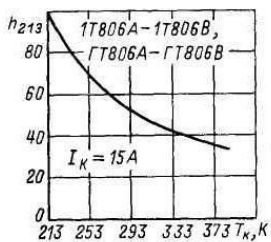
Примечания 1 При $T_K = 298 - 343$ К (при $T_K = 328$ К ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д) максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт, с теплоотводом рассчитывается по формуле

$$P_{К \text{ макс}} = (358 - T_K) / R_T \text{ п-к}$$

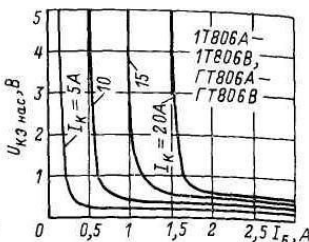
Не допускается отключение базы при наличии напряжения между коллектором и эмиттером. Не рекомендуется работа транзистора при рабочих токах, сопоставимых с неуправляемыми токами во всем диапазоне температур.

Эксплуатация транзисторов в режимах за пределами областей максимальных режимов, в том числе с учетом процессов, происходящих при включении и выключении, запрещается. При работе в импульсном режиме при отсутствии открывающего импульса транзистор должен быть закрыт положительным смещением базы $0,5 \text{ В} < U_{БЭ} < 2 \text{ В}$.

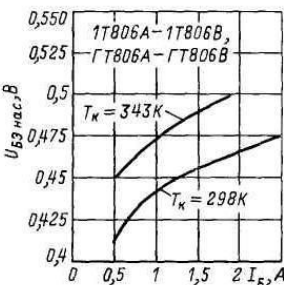
2. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 6 мм от корпуса транзистора. При включении транзистора в электрическую цепь, находящуюся под напряжением, коллекторный контакт должен подсоединяться последним и отсоединяться первым.



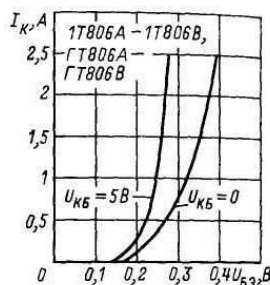
Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры корпуса



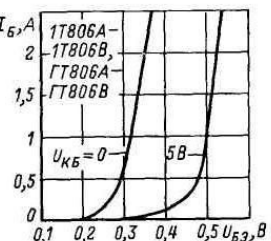
Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока базы



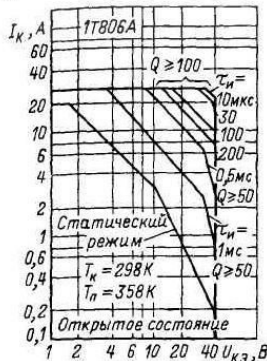
Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока базы



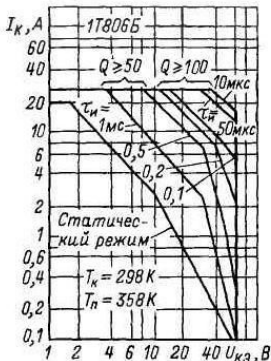
Зависимость тока коллектора от напряжения база-эмиттер



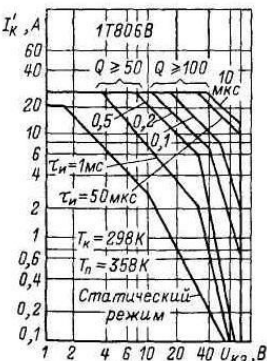
Входные характеристики.



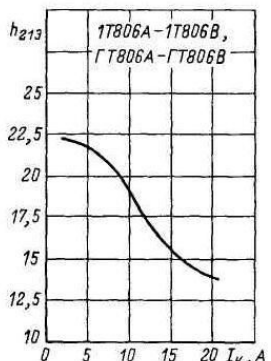
Область максимальных режимов.



Область максимальных режимов.



Область максимальных режимов.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора.